



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HS772

对应国外型号
2SB772

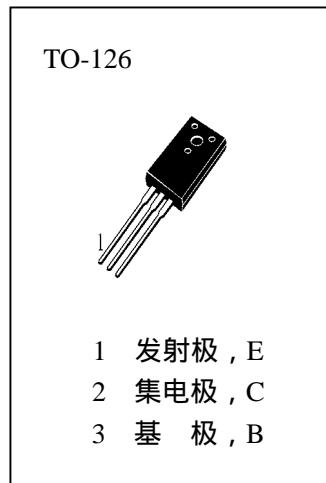
主要用途

音频放大、开关功率放大

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极功率耗散 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	10W
P_C ——集电极功率耗散 ($T_A=25^\circ\text{C}$)	1W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-40V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-30V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I_C ——集电极电流.....	-3A
I_B ——基极电流.....	0.6A

外形尺寸及引脚排列



电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-1	μA	$V_{CE}=-30\text{V}, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-1	μA	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$
h_{FE}	直流电流增益	60		400		$V_{CE}=-2\text{V}, I_C=-1\text{A}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降		-0.3	-0.5	V	$I_C=-2\text{A}, I_B=-0.2\text{A}$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和压降		-1.0	-2.0	V	$I_C=-2\text{A}, I_B=-0.2\text{A}$
C_{ob}	共基极输出电容		55		pF	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$
f_T	特征频率		80		MHz	$V_{CE}=-5\text{V}, I_E=-0.1\text{A}$

分档及其标志

R

Q

P

E

60—120

100—200

160—320

200—400